

Micron anuncia la serie 9400 de SSD de hasta 30 TB para el entorno empresarial



Micron le da una vuelta de tuerca a su catálogo de unidades de estado sólido (SSD) para el entorno empresarial con la **serie 9400**, compuesta por la subseries **9400 Pro** y la **9400 MAX**.

La primera está orientada a un uso mayormente de lectura con una durabilidad estándar de una grabación completa de la capacidad del disco por día durante cinco años, mientras que la segunda está orientada a sistemas que también escriban mucho en disco con una durabilidad de tres grabaciones de la SSD por día.

El formato es que se vende es el U.3, que es compatible con el U.2, y son como unidades de disco de 2.5 pulgadas (15 mm de grosor) pero con interfaz PCIe 4.0 x4 y con protocolo NVMe 1.4. Todas tienen un rendimiento de lectura/escritura similar, alcanzando los 7000 MB/s de lectura/escritura secuencia y

hasta 1.5/0.9 MIOPS de lectura/escritura aleatoria. Integran memoria NAND 3D de tipo TLC de 178 capas de la propia Micron.

Consumen hasta 20-25 W en escritura, que según Micron es hasta un 77 % mejor que la generación anterior. Por comparación, una PCIe 4.0 de un tera de PC puede consumir unos seis vatios y una de dos teras unos ocho vatios, y aquí se está hablando de 25 W por 30 TB.

Micron 9400 SSD Key Specifications

U.2/U.3		Micron 9400 PRO Read-Intensive, 1 Drive Write per Day			Micron 9400 MAX Mixed-Use, 3 Drive Writes per Day		
Capacity		7.68TB	15.36TB	30.72TB	6.40TB	12.80TB	25.60TB
Performance ⁷ (4K random 128K sequential)	Seq. Read (MB/s)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	Seq. Write (MB/s)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	Rand. Read (IOPS)	1,600,000	1,600,000	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,500,000
	Rand. Write (IOPS)	300,000	300,000	300,000	600,000	600,000	550,000
	70/30 Rand. Read/Write (IOPS)	770,000	780,000	770,000	930,000	940,000	900,000
Endurance (total bytes written in TB)	Latency (typical, µs) ⁸	69 (read) 10 (write)	69 (read) 10 (write)	69 (read) 10 (write)	69 (read) 10 (write)	69 (read) 10 (write)	69 (read) 10 (write)
	4K Rand.	14,016	28,032	56,064	35,040	70,080	140,160
Basic Attributes	128K Seq.	58,300	104,500	201,200	74,200	143,100	282,600
	Interface	PCIe Gen4 1x4 NVMe (v1.4)					
Reliability	NAND	Micron 176-layer 3D TLC NAND					
	MTTF	2 million device hours					
	UBER	<1 sector per 10 ¹⁷ bits read					
Environmental Characteristics	Warranty	5 years					
	Power Consumption (average, watts, RMS ⁹)	128K Seq. Read 14 128K Seq. Write 19 4K Rand. Read 17 4K Rand. Write 21 4K Rand. 70/30 Read/Write 21	128K Seq. Read 16 128K Seq. Write 21 4K Rand. Read 19 4K Rand. Write 25 4K Rand. 70/30 Read/Write 23	128K Seq. Read 17 128K Seq. Write 23 4K Rand. Read 21 4K Rand. Write 25 4K Rand. 70/30 Read/Write 24	128K Seq. Read 14 128K Seq. Write 19 4K Rand. Read 17 4K Rand. Write 21 4K Rand. 70/30 Read/Write 18	128K Seq. Read 16 128K Seq. Write 21 4K Rand. Read 19 4K Rand. Write 24 4K Rand. 70/30 Read/Write 20	128K Seq. Read 17 128K Seq. Write 23 4K Rand. Read 21 4K Rand. Write 25 4K Rand. 70/30 Read/Write 21
Operating Temp.		0-70°C					

Fuente: Micron.